

## 2Т602Б

Транзисторы кремниевые планарные структуры n-p-n.

Предназначены для генерирования и усиления сигналов.

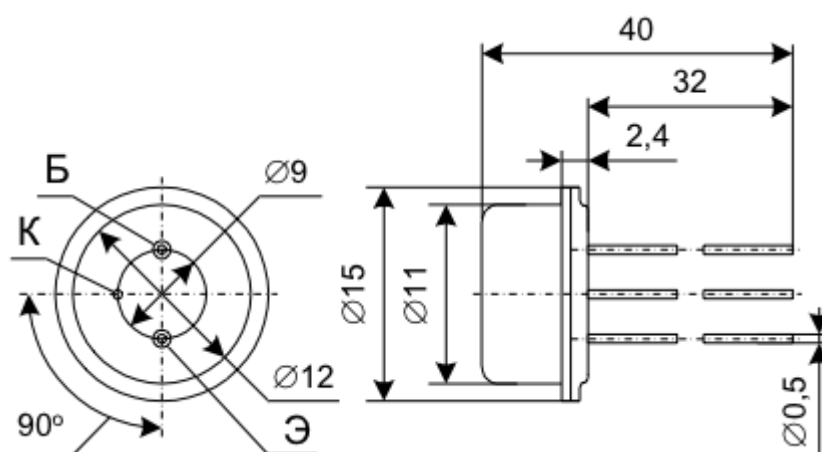
Транзисторы выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов не более 5 г.

Технические условия: И93.365.000 ТУ.

Изготовитель - ВЗПП, г. Воронеж.



### Основные технические характеристики транзистора 2Т602Б:

- $h_{21э}$  - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 50... 200;
- $f_{гр}$  - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 150 МГц;
- $C_{к}$  - Емкость коллекторного перехода: не более 4 пФ;
- $t_{к}$  - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 300 пс;
- $I_{кбо}$  - Обратный ток коллектора при обратном напряжении коллектор-база  $U_{кбо} = 120$  В: не более 10 мкА;
- $U_{кб\ max}$  - Максимальное постоянное (импульсное) напряжение коллектор-база: 120 (160) В;
- $U_{кэ\ max}$  - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{бэ} = 1$  кОм: 100 В;
- $U_{эб\ max}$  - Максимальное напряжение эмиттер-база: 5 В;
- $I_{к\ max}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 75 мА;
- $I_{к\ и\ max}$  - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 500 мА;
- $P_{к\ max}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 0,85 Вт;
- $P_{к\ т\ max}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: не более 2,8 Вт.